

02-9369-02
621.382.3
Россия
М.З.

**МОЩНЫЕ n-p-n
БИПОЛЯРНЫЕ
ТРАНЗИСТОРЫ КТ858А
и КТ8140А1**

УДК 621.382.3.026
ОКП 34 1781
ГРНТИ 45.37.29.33.29



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

**ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАТАЛОГ
05.15.10-01**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Транзисторы биполярные переключаемые КТ858А и КТ8140А1 предназначены для использования в качестве выходных ключей блоков строчной развертки телевизоров и мониторов черно-белого изображения.

**Структура условного обозначения
КТ8ХА(1):**

- КТ – транзистор кремниевый биполярный;
- 8 – обозначение назначения транзистора (большой мощности с граничной частотой от 3 до 30 МГц);
- Х – порядковый номер разработки (58; 140);
- А – классификационная группа по параметрам;
- 1 – конструктивное исполнение (тип корпуса КТ-28)

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации транзистора КТ858А в соответствии с требованиями АО.336.553 ТУ-95, транзистора КТ8140А1 – АДБК.432.140.373 ТУ-95, в том числе:

- температура окружающей среды от минус 60 до 100 °С;
- температура корпуса транзисторов от минус 40 до 100 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Предельно допустимые значения параметров транзисторов приведены в табл. 1, статические и динамические характеристики – в табл. 2.

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры транзисторов в корпусе КТ-28 (ТО-220) представлены на рис. 1, электрические схемы транзисторов – на рис. 2, а, б.

Масса транзисторов не более 3 г.

Таблица 1

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Значение параметра для транзисторов типов		Режим измерения*
		КТ858А	КТ8140А1	
Граничное напряжение, В	$U_{кэ0 гр}$	200		$I_{к0}=0,1 А$ $L_{к0}=25 мГн$
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{кэк max}$	400		$I_{кэк}=1 мА$ $R_{БЭ}=0$
Максимально допустимое напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ0 max}$	6		$I_{ЭБ0}=1 мА$ $I_{к0}=0$
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{к max}$	7		-
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{к, ИМП max}$	10		-

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Значение параметра для транзисторов типов		Режим измерения*
		КТ858А	КТ8140А1	
Максимально допустимый постоянный ток базы, А	$I_{Б\text{ макс}}$	4		—
Максимально допустимый импульсный ток базы, А	$I_{Б, \text{ИМП макс}}$	4		—
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт	$P_{К\text{ макс}}$	60		$T_{П}=150\text{ }^{\circ}\text{C}$
Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	$T_{П\text{ макс}}$	150		—

Таблица 2

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Значение параметра для транзисторов типов		Режим измерения*
		КТ858А	КТ8140А1	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА: типовой максимальный	$I_{КЭК}$	0,5	0,1 1	$U_{КЭК}=400\text{ В}$ $R_{БЭ}=0$
Обратный ток эмиттер-база, мА: типовой максимальный	$I_{ЭБО}$	0,1 1	— 200	$U_{ЭБО}=6\text{ В}$ $I_{К}=0$
Статический коэффициент передачи тока: минимальный типовой	$h_{21Э}$	20	10 15	$I_{К}=5\text{ А}$ $U_{КЭ}=5\text{ В}$
Максимальное напряжение насыщения база-эмиттер, В	$U_{КЭ\text{ нас}}$	1		$I_{К}=5\text{ А}$ $I_{Б}=0,08\text{ А}$
Максимальное напряжение насыщения база-эмиттер, В	$U_{БЭ\text{ нас}}$	1,2		
Время спада коллекторного тока, мкс: типовой максимальное	$t_{сп}$	0,35 0,75	0,3	$I_{К}=5\text{ А}$ $I_{Б}=\pm 0,5\text{ А}$
Прямое напряжение на диоде, В	U_{FD}	—	1,6	$I_{FD}=3\text{ А}$
Максимальное тепловое сопротивление переход-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Т\text{ П-К}}$	2,08		$U_{КЭ}=20\text{ В}$ $I_{К}=3\text{ А}$

* Температура корпуса 25 $^{\circ}\text{C}$.

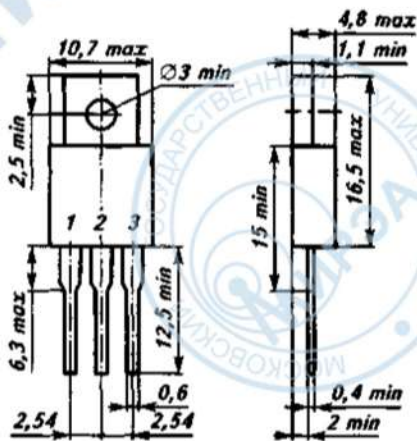


Рис. 1. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры транзисторов КТ858А и КТ8140А1 в корпусе КТ-28:
1 – база; 2 – коллектор; 3 – эмиттер

Показатели надежности:
минимальное время наработки 15 000 ч;
интенсивность отказов в течение времени наработки не более 10^{-6} 1/ч;
минимальный 99,5% срок сохраняемости – 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: транзисторы, этикетка (паспорт) с краткими техническими данными транзисторов, потребительская тара.

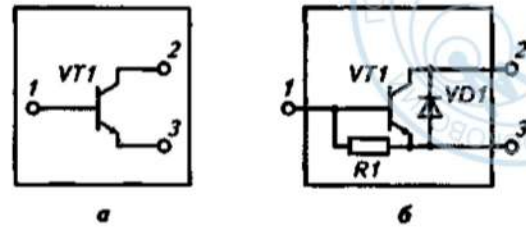


Рис. 2. Электрическая схема транзисторов:

а – КТ858А:

VT1 – транзистор; 1–3 – по рис. 1; б – КТ8140А1:

R1 – согласующий резистор 100 Ом; VD1 – демпферный диод;
1–3 – по рис. 1; VT1 – по рис. 2, а

Типовое количество транзисторов в единице тары – 200 шт.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать: наименование и тип транзистора, обозначение технических условий, количество (желательно кратное 200).

Пример: „Транзистор биполярный КТ8140А1, АДБК.432.140.373 ТУ–95, 600 шт.“.

Разработчик и изготовитель

ЗАО „Фрязинский завод мощных транзисторов“
(ЗАО „ФЗМТ“)
141190, Россия, Московская обл., г. Фрязино,
Заводской пр., 3
Тел./факс: (095) 465-88-99



ПК 05.15.10-01 (0740)

Главный редактор Е.Г. Акимов
Составитель Х.А. Голубь
Технический редактор Г.П. Федорова
Корректор А.А. Чередниченко
Компьютерная графика В.А. Ермоленко
Компьютерная верстка А.Н. Пучкова

ЛР-020744 от 18 марта 1998 г.

105037, Москва Е-37,
Институт промышленного развития (Информэлектро)
Телефон для справок 165-21-90.

Сдано в набор 09.12.2000. Подписано к печати 02.02.2001.
Формат 60x90 1/8. Печать офсетная. Усл.печ. л. 0,5.
Усл.кр.-отт. 0,62. Уч.-изд. л. 0,4.